

(iv)  $G_{ps}$  is a common source large signal insertion power gain, and

(v)  $G_{pd}$  is a common drain large signal insertion power gain,

(c) gain bandwidth product, or

(d) noise figure. (*fréquence de fonctionnement*)

(2) Transistors, and dice and wafers therefor, as follows:

(a) transistors that are based on silicon and

(i) have an operating frequency greater than 1.5 GHz,

(ii) have an operating frequency of 1.5 MHz or less and a maximum collector dissipation greater than 300 W,

(iii) have an operating frequency greater than 1.5 MHz and a maximum collector dissipation greater than 250 W,

(iv) have an operating frequency greater than 200 MHz and a product of the operating frequency in gigahertz times the maximum collector dissipation in watts greater than 10, or

(v) are majority carrier devices, including junction field effect transistors and metal oxide semiconductor transistors, other than field effect transistors that have a maximum operating power dissipation of

(A) not more than 6 W and a maximum operating frequency of 1 GHz, or

(B) not more than 1 W and a maximum operating frequency of 2 GHz;

(b) transistors that are based on gallium arsenide and have

(i) an operating frequency greater than 1 GHz,

(ii) a maximum power dissipation greater than 1 W, or

(iii) a noise figure of less than 3 dB; and

(c) transistors that are based on any semiconductor material other than germanium, silicon or gallium arsenide.

#### Thyristors

1547 (1) In this item,

“figure of merit” means the product of V DRM in kilovolts and I TRM in amperes, as shown on thyristor data sheets; (*figure de mérite*)

“turn-off time” in respect of gate-turn-off thyristors, means the sum of the gate-controlled delay time and the gate-controlled fall time required to reach 10 per cent of the initial on-state current. (*temps de coupure*)

(2) Thyristors, and dice and wafers therefor, as follows:

(a) thyristors that are designed for use in pulse modulators and that have a rated turn-on time of less than 1  $\mu$ s where the rated peak current is greater than 150 A;

(b) thyristors that have a rated turn-off time of less than 1  $\mu$ s;

(iv)  $G_{ps}$  est le gain en puissance pour montage à source commune avec signal fort,

(v)  $G_{pd}$  est le gain en puissance pour montage à drain commun avec signal fort;

c) le produit gain-bande passante;

d) le facteur de bruit. (*operating frequency*)

(2) Transistors et leurs pastilles et plaquettes, à savoir:

a) transistors à base de silicium qui, selon le cas:

(i) ont une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 GHz,

(ii) ont une fréquence de fonctionnement d'au plus 1,5 MHz et une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 300 W,

(iii) ont une fréquence de fonctionnement supérieure à 1,5 MHz et une puissance maximale dissipée au collecteur supérieure à 250 W,

(iv) ont une fréquence de fonctionnement supérieure à 200 MHz et un produit de la multiplication de la fréquence de fonctionnement, exprimée en gigahertz, par la puissance maximale dissipée au collecteur, supérieure à 10 W,

(v) sont des dispositifs à porteurs majoritaires, notamment transistors à effet de champ à jonction et transistors à semi-conducteur d'oxyde métallique, à l'exclusion des transistors à effet de champ ayant:

(A) soit une puissance maximale dissipée d'au plus 6 W et une fréquence de fonctionnement maximale d'au plus 1 GHz,

(B) soit une puissance maximale dissipée d'au plus 1 W et une fréquence de fonctionnement maximale d'au plus 2 GHz;

b) transistors à base d'arséniure de gallium qui ont, selon le cas:

(i) une fréquence de fonctionnement supérieure à 1 GHz,

(ii) une puissance maximale dissipée supérieure à 1 W,

(iii) un facteur de bruit inférieur à 3 dB;

c) transistors à base de tout matériau semi-conducteur autre que le germanium, le silicium ou l'arséniure de gallium.

#### Thyristors

1547 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«figure de mérite» Le produit de la V DRM, le thyristor étant en coupure, exprimée en kilovolts, par le I TRM, le thyristor étant en circuit, exprimé en ampères, figurant dans les feuilles de spécifications concernant les thyristors. (*figure of merit*)

«temps de coupure» Dans le cas des thyristors à grille de commande, la somme du retard commandé par la grille et du retard à la descente commandé par la grille pour atteindre 10 pour cent du courant initial à l'état passant. (*turn-off time*)

(2) Thyristors et leurs pastilles et plaquettes qui, à la fois:

a) sont conçus pour être utilisés dans des modulateurs d'impulsions et qui ont un temps d'établissement du courant nominal de moins de 1  $\mu$ s lorsque le courant de crête nominal est supérieur à 150 A;

b) ont un temps de coupure nominal de moins de 1  $\mu$ s;